

Title (en)

Process for anodising aluminium products and aluminised parts.

Title (de)

Verfahren zum Anodisieren von Aluminiumwerkstoffen und aluminierten Teilen.

Title (fr)

Procédé d'anodisation de produits en aluminium et pièces aluminées.

Publication

**EP 0090268 A2 19831005 (DE)**

Application

**EP 83102616 A 19830316**

Priority

DE 3211759 A 19820330

Abstract (en)

[origin: US4439287A] Aluminum materials and aluminized parts are oxidatively anodized at a bath temperature of 0 DEG to 15 DEG C. and preferably, 0 DEG to 10 DEG C. to produce an anodized layer of aluminum oxide more than 4 microns thick, which is hard, abrasion-proof and can be stained. The anodizing is bath used while conducting air free of or low in carbon dioxide through the bath. It is free of substances which limit the oxide layer to maximally a thickness of about 1 micron (forming layer) and contains 10 to 500 g trisodium phosphate or tripotassium phosphate per liter. In partially aluminized parts, no destruction of the base material occurs during the aluminizing.

Abstract (de)

Aluminiumwerkstoffe und aluminierte Teile werden bei 0 bis 15°C, vorzugsweise 0 bis 10°C Badtemperatur und Durchleiten von CO<sub>2</sub>-freier oder CO<sub>2</sub>-armer Luft anodisch mit einer 10 bis 20 µm dicken harten und abriebfesten sowie einfärbbaren Anodisierschicht versehen. Das eingesetzte Anodisierbad ist frei von Stoffen, die die Oxidschicht auf maximal 1 µm Dicke begrenzen (Formierschicht) und enthält pro Liter 10 bis 500 g Trinatriumphosphat oder Trikaliumphosphat. Bei partiell aluminierten Teilen tritt während des Anodisierens keine Zerstörung des Grundwerkstoffes ein.

IPC 1-7

**C25D 11/04**; **C25D 11/08**

IPC 8 full level

**C25D 11/04** (2006.01); **C25D 11/06** (2006.01); **C25D 11/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 11/024** (2013.01 - EP US); **C25D 11/04** (2013.01 - EP US); **C25D 11/08** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0090268 A2 19831005**; **EP 0090268 A3 19850515**; **EP 0090268 B1 19870805**; AT E28760 T1 19870815; DE 3211759 A1 19831006; DE 3372871 D1 19870910; JP H0359149 B2 19910909; JP S58177493 A 19831018; US 4439287 A 19840327

DOCDB simple family (application)

**EP 83102616 A 19830316**; AT 83102616 T 19830316; DE 3211759 A 19820330; DE 3372871 T 19830316; JP 5229783 A 19830328; US 48007283 A 19830329